

SPECIFICATION TRANSISTORS, DIODES.

NO. 17 - 2T-1323

2 S C 1 4 7 5

PAGE: 2/20/73

暫 定



DATE: / /

1. 構造 NPN・APM形・エピタキシャル・シリコン・トランジスタ
2. 用途 低周波～高周波電力増巾，スイッチング
3. 外形 付図参照
4. 絶対最大定格 (Ta=25°C)

*GAIN GROUPS -  
2, 3, 4 w own  
option  
10K w, 20  
30 days from  
D.O.A.*

コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CBO</sub>	100V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	50V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	6V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	1A
ベース電流	I <sub>B</sub>	0.5A
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	750mW
ジャンクション温度	T <sub>j</sub>	150°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-50°C～+150°C

5. 電気的特性 (Ta=25°C)

項目	記号	条件	最小値	標準値	最大値	単位
コレクタ遮断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> =25V, I <sub>E</sub> =0			0.2	μA
エミッタ遮断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> =6V, I <sub>C</sub> =0			0.2	μA
ベース・エミッタ電圧	V <sub>BE</sub>	V <sub>CE</sub> =6V, I <sub>C</sub> =5mA			0.70	V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO(sus)</sub>	I <sub>C</sub> =2mA	50			V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> =1A, I <sub>B</sub> =50mA			0.3	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V <sub>BE(sat)</sub>				1.0	V
直流電流増巾率	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> =2V, I <sub>C</sub> =100mA	98		649	
直流電流増巾率	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> =1V, I <sub>C</sub> =1A	70			
小信号電流増巾率	h <sub>fe</sub>	V <sub>CB</sub> =2V, I <sub>E</sub> =10mA, f=10MHz		18		dB
コレクタ出力容量	C <sub>C</sub>	V <sub>CB</sub> =10V, I <sub>E</sub> =0A, f=1MHz		16	40	pF
熱抵抗	θ <sub>j-a</sub>				126	°C/W

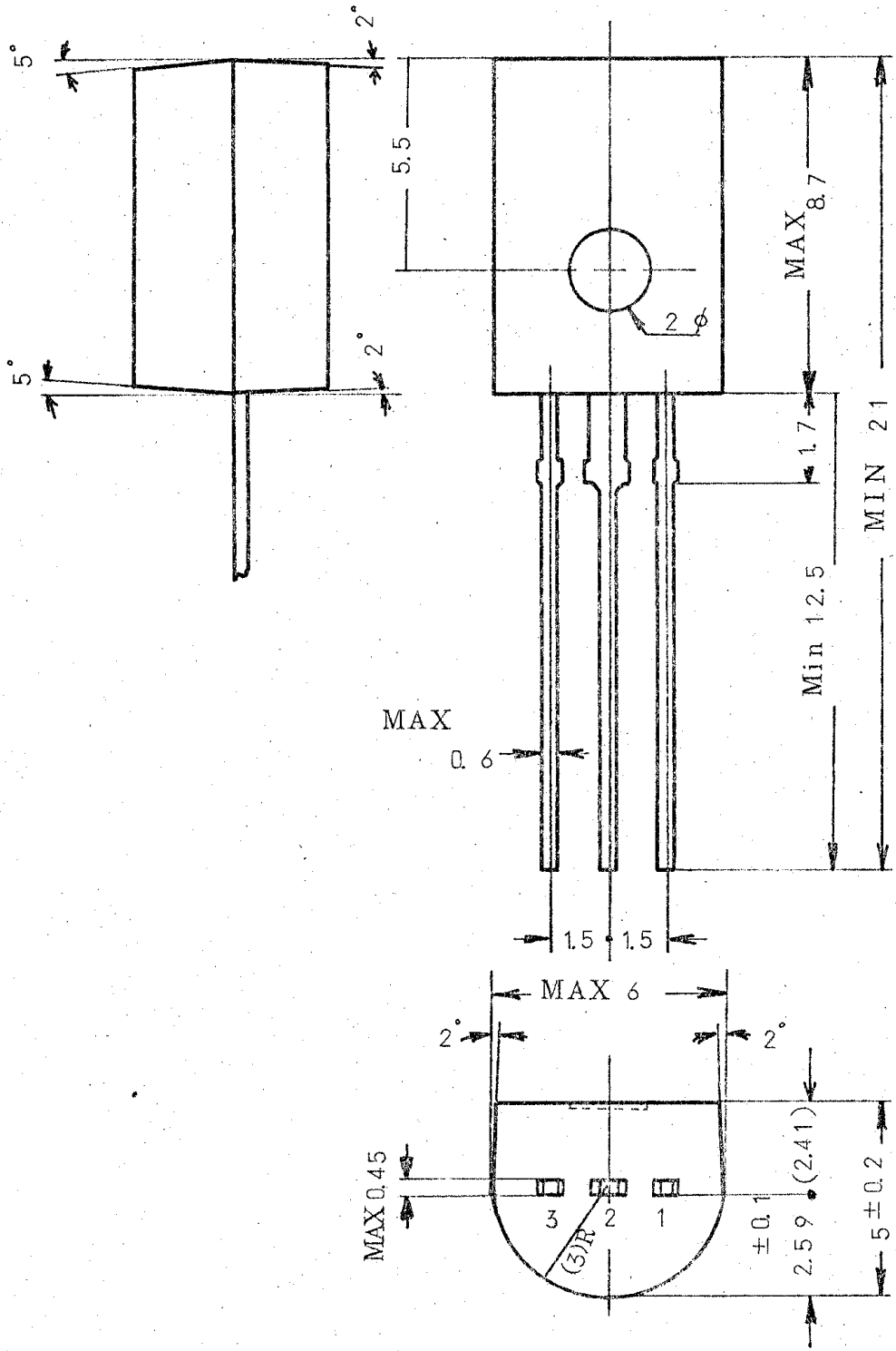
DATE

TOSEI CO. INC

NAME

6. 規格細分

	$h_{FE1} (V_{CE}=2V, I_C=100mA)$	
	最小値	最大値
1	98	156
2	140	222
3	199	316
4	285	451
5	409	649



- 1 ベース
- 2 コレクタ
- 3 エミッタ

(1/1)